

1000–12000 MHz GaN Die commutatore SPDT MMIC

Perdita di inserzione: 1 dB (tipico); Isolamento: 34 dB (minimo) / 63 dB (massimo);
Potenza di ingresso alla compressione di 0.2 dB: 43 dBm (tipico). Dimensioni del die: 2.45 × 1.2 × 0.1 mm.



Caratteristiche RF · TA = +25 °C

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Valore	Unità
Frequenza operativa	-	1000	-	12000	1000–12000	MHz
Perdita di inserzione	-	-	1	-	-	dB
Isolamento	-	34	-	63	-	dB
Potenza di ingresso alla compressione di 0.2 dB	-	-	43	-	-	dBm
Tempo di commutazione	-	-	10	-	-	ns

Polarizzazione DC e correnti

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Valore	Unità
Tensione di controllo	-	-	-	-	V1 = -28 V; V2 = 0 V (RFC ↔ RF1)	-
Tensione di controllo	-	-	-	-	V1 = 0 V; V2 = -28 V (RFC ↔ RF2)	-

Valori limite

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Polarizzazione minima del gate	-	-60	-	-	V
Potenza di ingresso massima	-	-	-	43	dBm

Condizioni ambientali

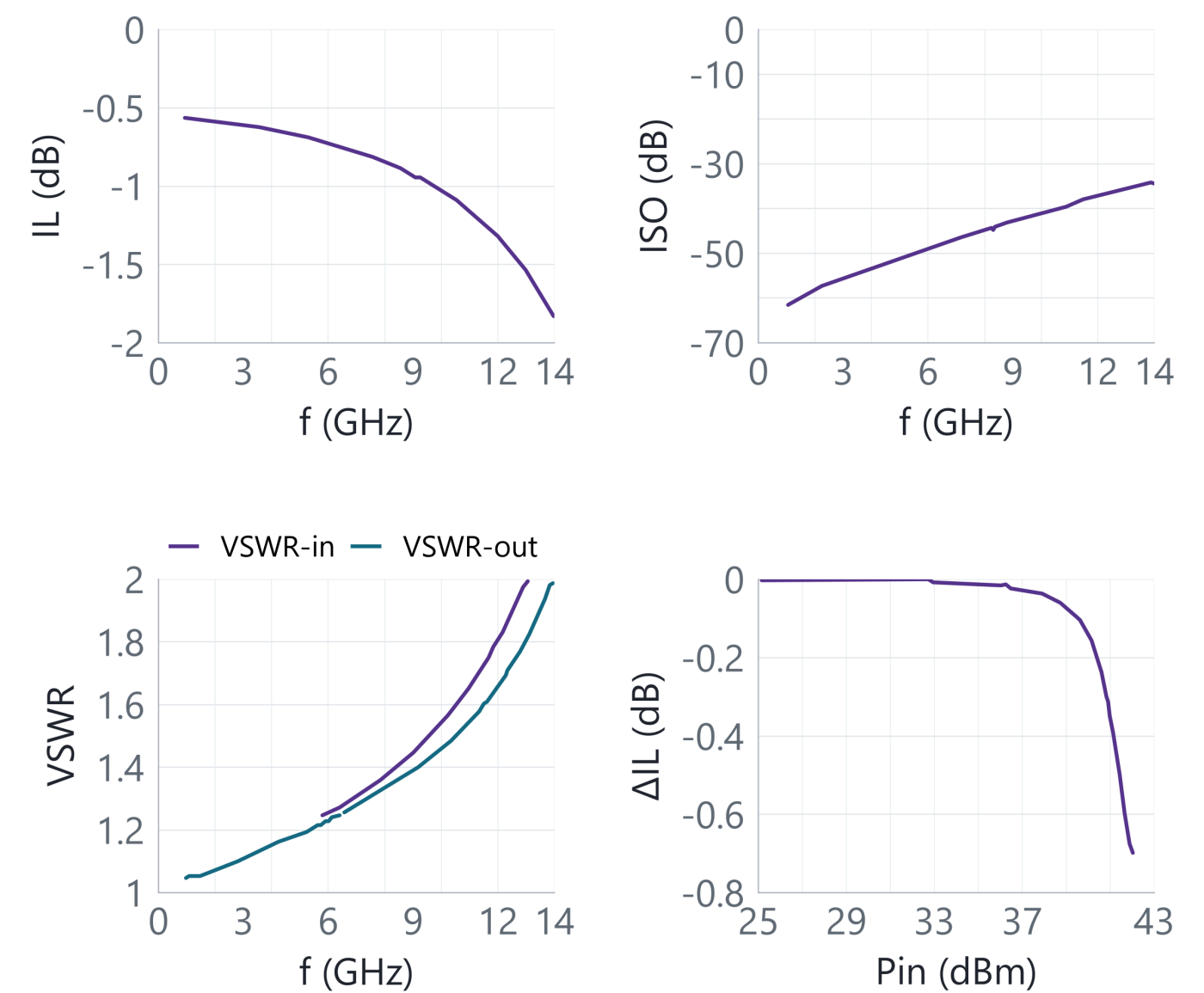
Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Temperatura di stoccaggio	-	-65	-	150	°C
Temperatura operativa	-	-55	-	85	°C

Curve di prestazione

Grafici tratti dalla scheda tecnica originale. Consultare ogni figura insieme alle condizioni operative indicate.

Adattamento d'ingresso e d'uscita; Isolamento; Perdita di inserzione; Δ IL (dB).

Indicazione nella pagina originale: TA=+25°C. Curva ridisegnata dall'immagine originale; i valori letti sono approssimativi. f = 6 GHz; Pin = 25–43 dBm. IL e ISO mantengono i segni negativi in dB della fonte. Il grafico di compressione mostra Δ IL a 6 GHz rispetto a Pin, senza definire una soglia di compressione a 1 dB.



[Fonte](#)

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L'offerta approvata e la documentazione d'ordine definiscono la configurazione fornita.